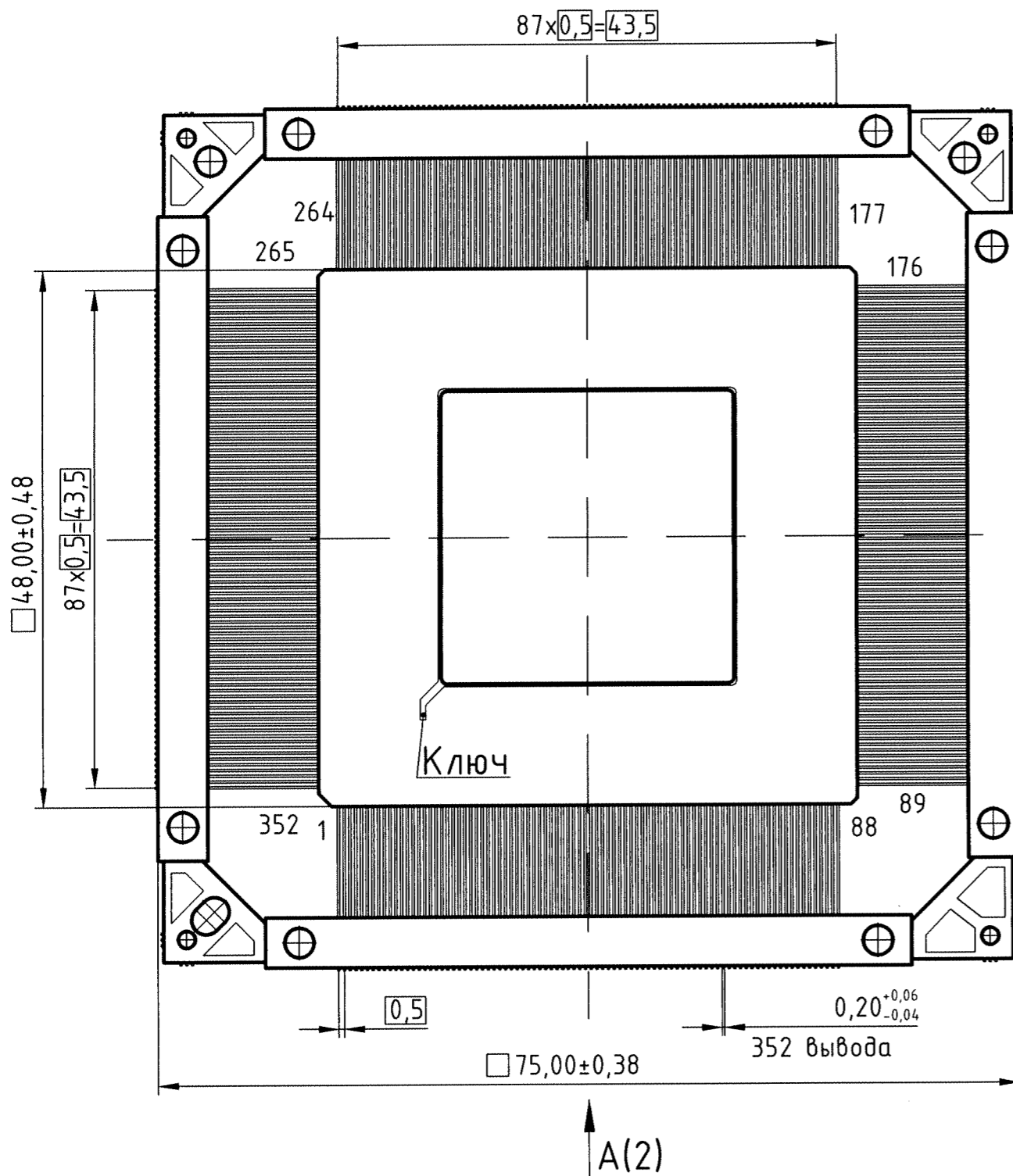


Г АВЛ.431268.021СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.021)

(см. продолжение на листах 2, 3, 4, 5)



1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$.
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать состав маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно виду Б для микросхемы 5529ТР104 и согласно виду Е для микросхемы 5529ТР104А. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду В для микросхемы 5529ТР104, виду Ж для 5529ТР104А.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
14. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.
16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР104 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.021ЭТ, 5529ТР104А - Г АВЛ.431268.021-01ЭТ.
17. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

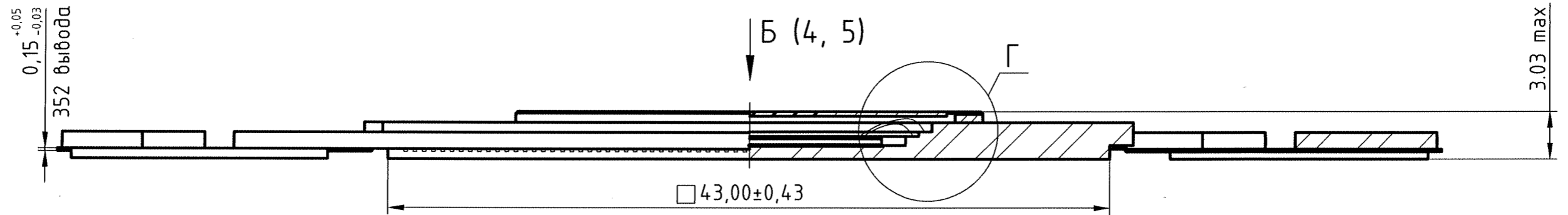
Таблица 1 - Модификация

Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.021	5529ТР104	МК 4254.352-2	5529ТР104	max 29,0 г	1
-01	5529ТР104А	МК 4251.304-2	5529ТР104А	max 23,0 г	2

Г АВЛ.431268.021СБ					
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата	Лит.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Масса
Разраб.	Астахова	13.11.19			Масштаб
Пров.	Тикашкин	13.11.19			А
Микросхемы интегральные 5529ТР104, 5529ТР104А Сборочный чертеж					-
					2:1
512 ВП Чириченко					Лист 1
Н.контр. Казаков					Листов 9
Утв. Денисов					

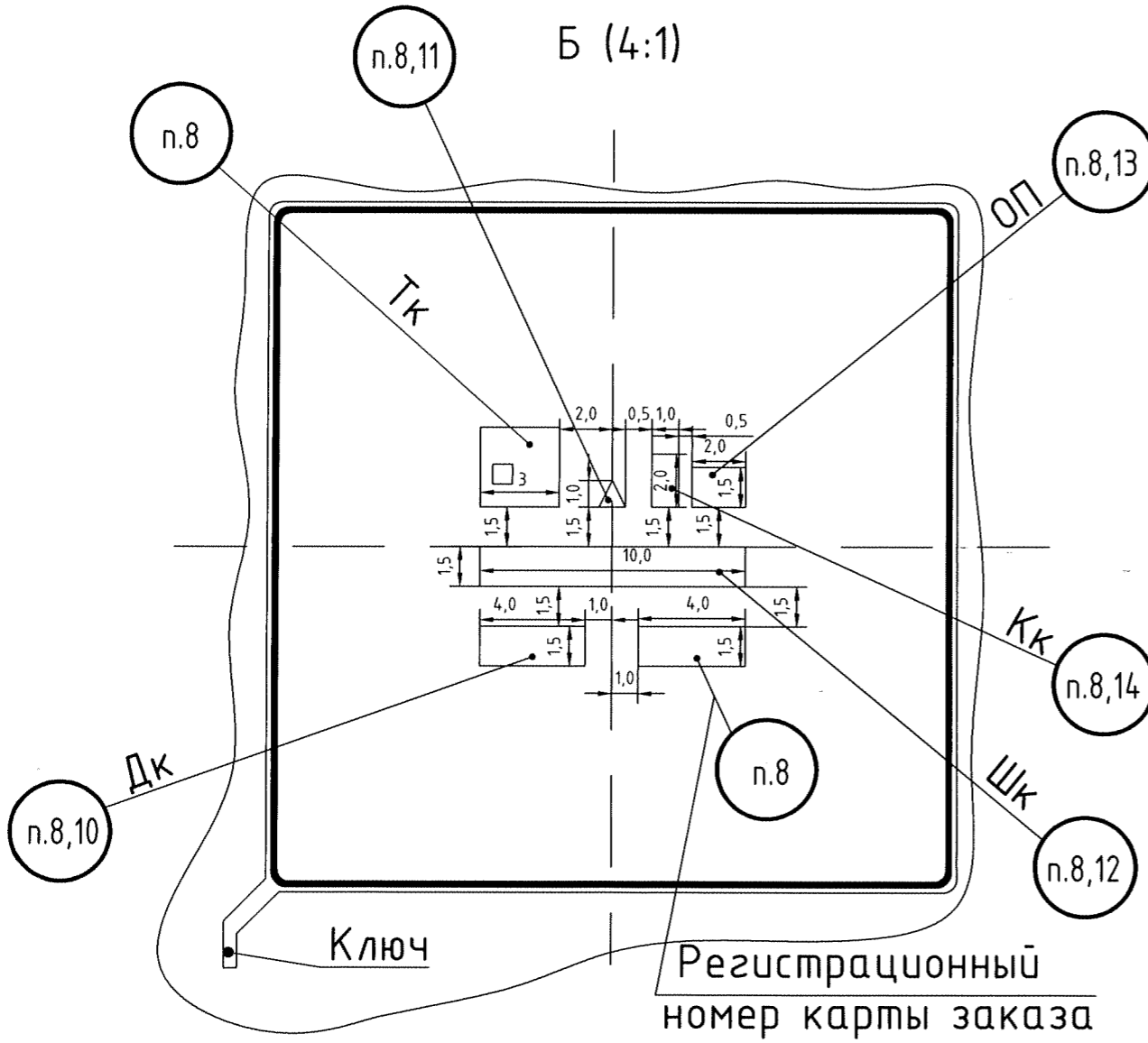
Рис.1 (продолжение)
(ГВЛ.431268.021)

А (4:1) (1)

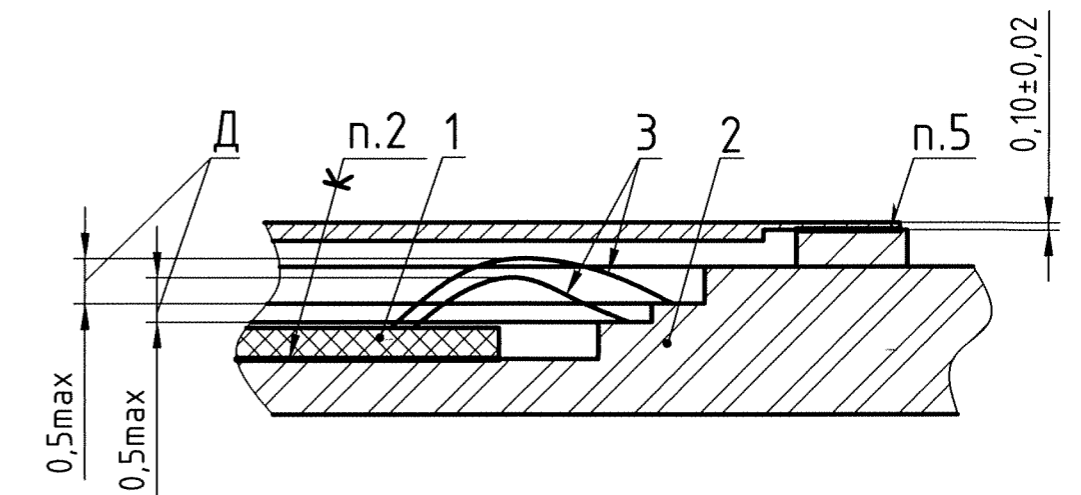


В (3)

Б (4:1)



Г (10:1)

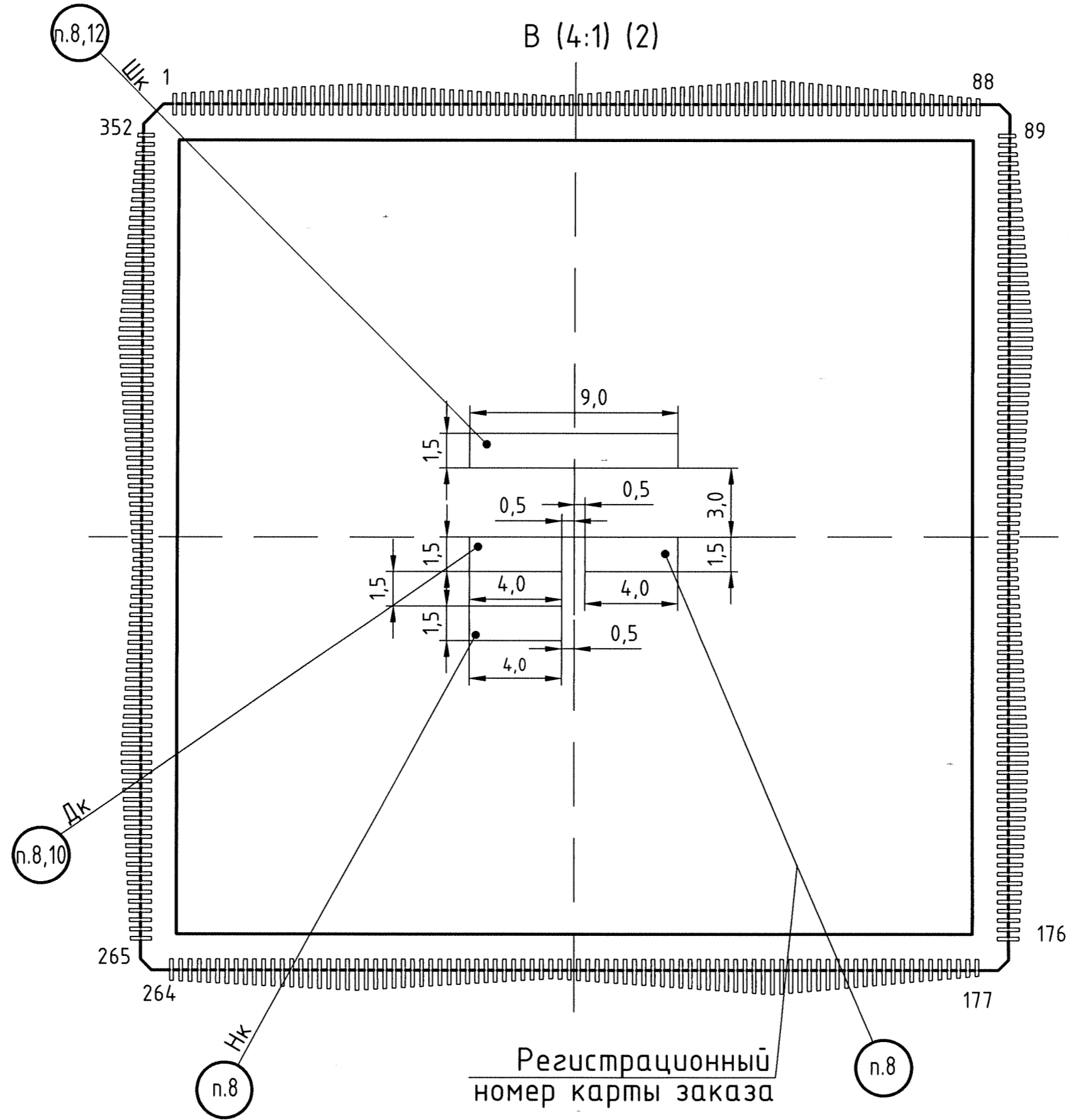


Инв. № подл.	1604
Подп. и дата	Prof. doc. 01.20
Взам. инв. №	
Инв. № дубл	
Подп. и дата	

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	СВ	08.15	ГВЛ.431268.021СБ	Лист
Изм/Лист	№ Докум.	Подп.	Дата			2

Рис.1 (продолжение)
(ГВЛ.431268.021)

В (4:1) (2)



Инв. № подл. 1607	Подп. и дата <i>С.А. Сид.</i> 01.10	Взам. инв. № Инв. № дубл.	Подп. и дата
----------------------	--	---------------------------	--------------

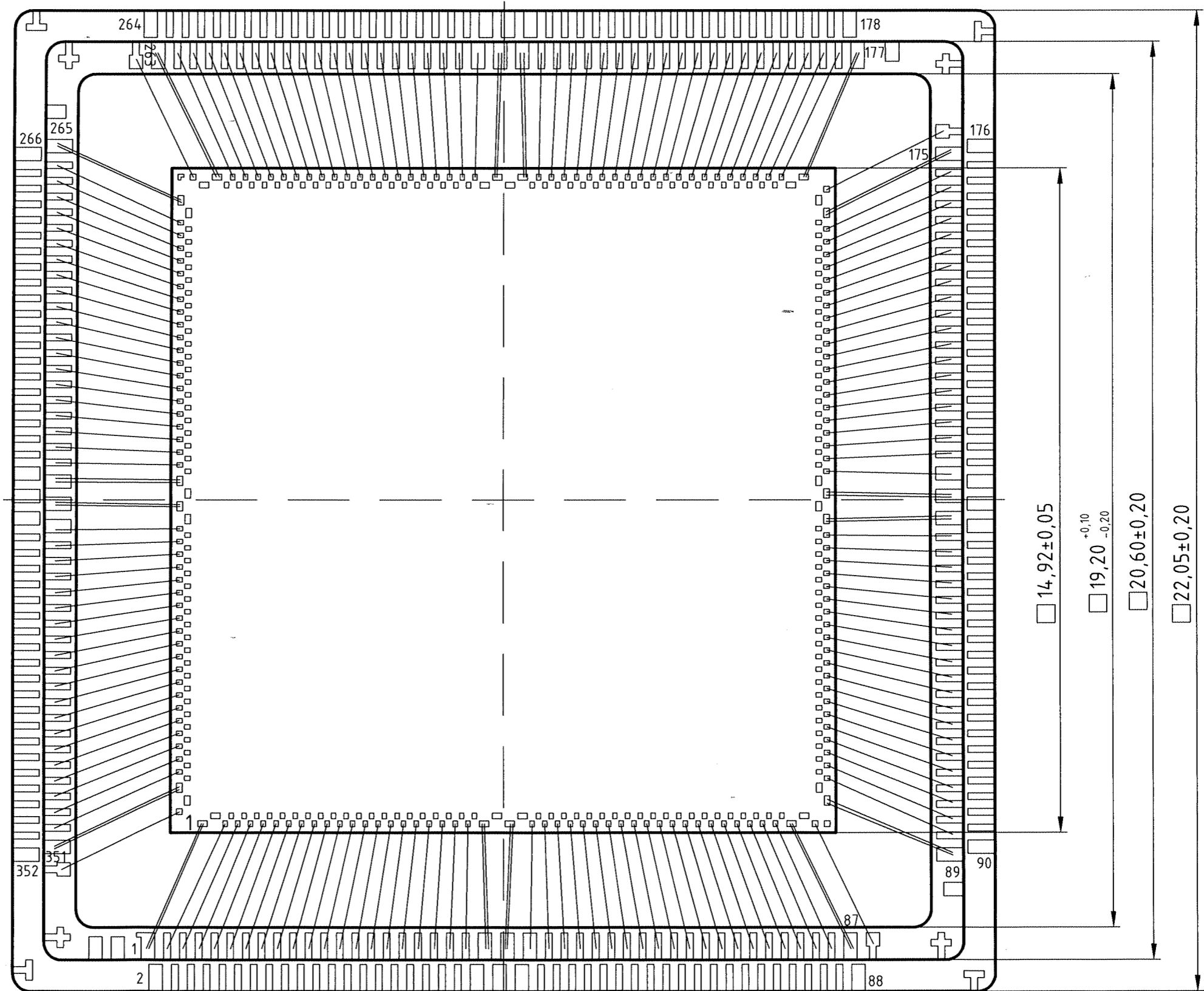
1	Зам.	ГВЛ.09-2019	<i>С.А. Сид.</i>	09.10
Изм./Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	

ГВЛ.431268.021СБ

Рис.1 (продолжение)
(ГВЛ.431268.021)

Б (10:1) (2)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внутренние площадки колодца



Инв. № подл. 1604	Подп. и дата <i>Сид. 01.01.20</i>	Взам. инв. № Инв. № дцбл	Подп. и дата
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------

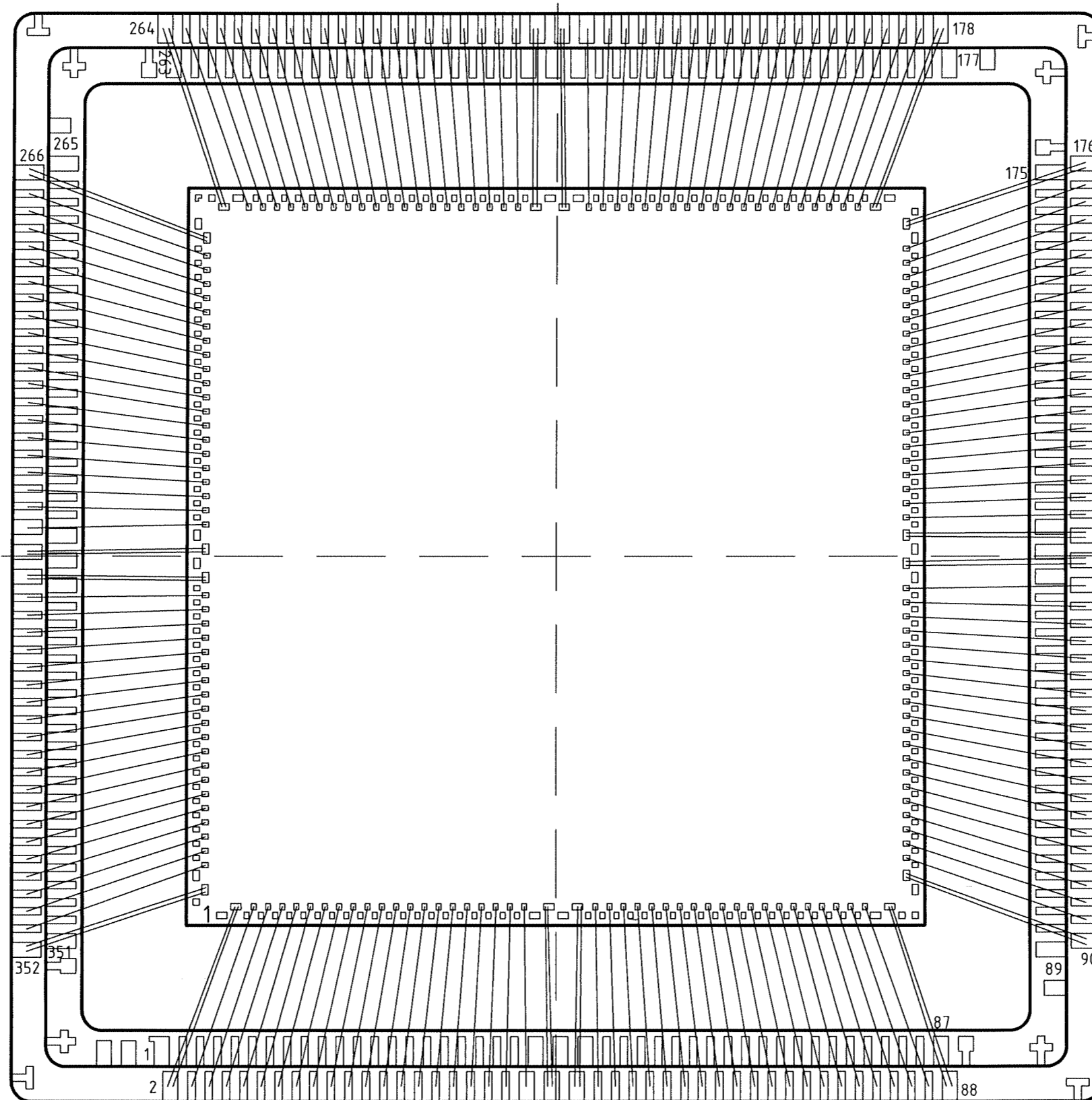
1	Зам.	ГВЛ.09-2019	<i>Сид</i>	08.01.19
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

ГВЛ.431268.021Б

Рис.1 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.021)

Б (10:1) (2)

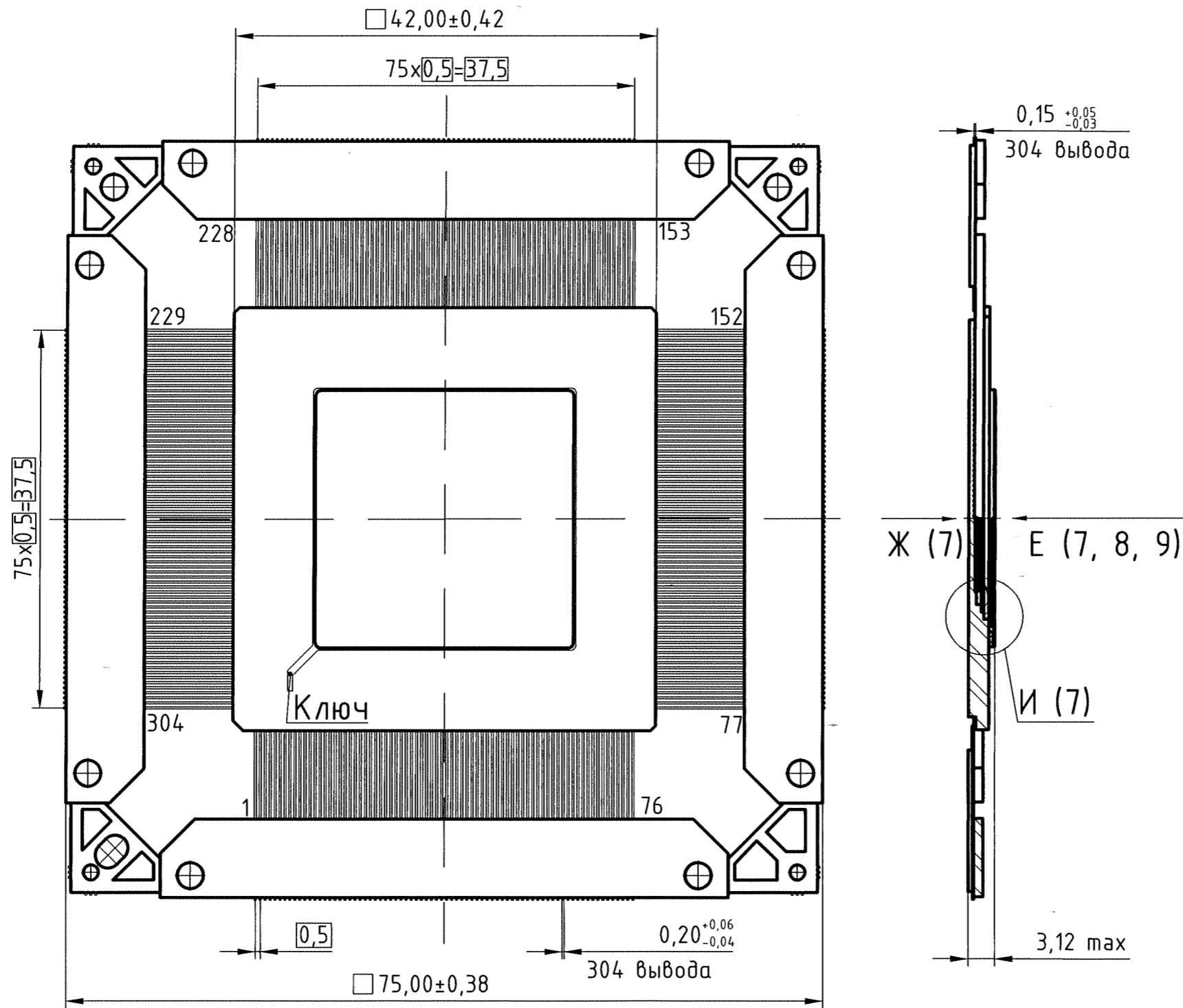
Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внешние площадки колодца



Инв. № подл. 1603	Подп. и дата 24.02.2019	Взам. инв. №	Инв. № дц/дл	Подп. и дата
----------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Date]</i>
Изм/Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	

Рис.2 (Г АВЛ.431268.021-01)
(см. продолжение на листах 7, 8, 9)



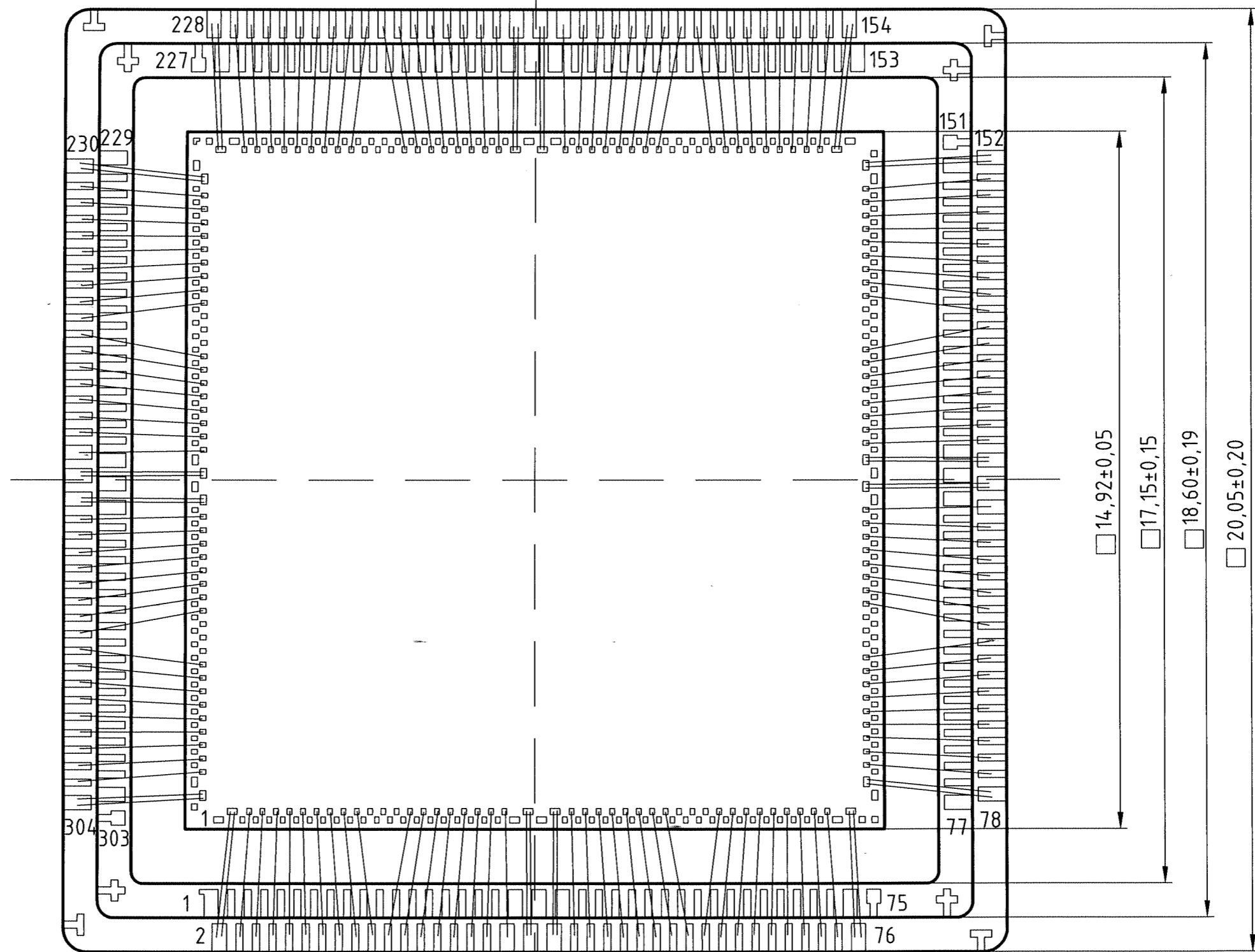
Инв. № подл.	1604
Подп. и дата	Ж.А.А.А.А.
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

Рис.2 (продолжение)
 (ГВЛ.431268.021-01)

Е (10:1) (6)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внешние площадки колодца



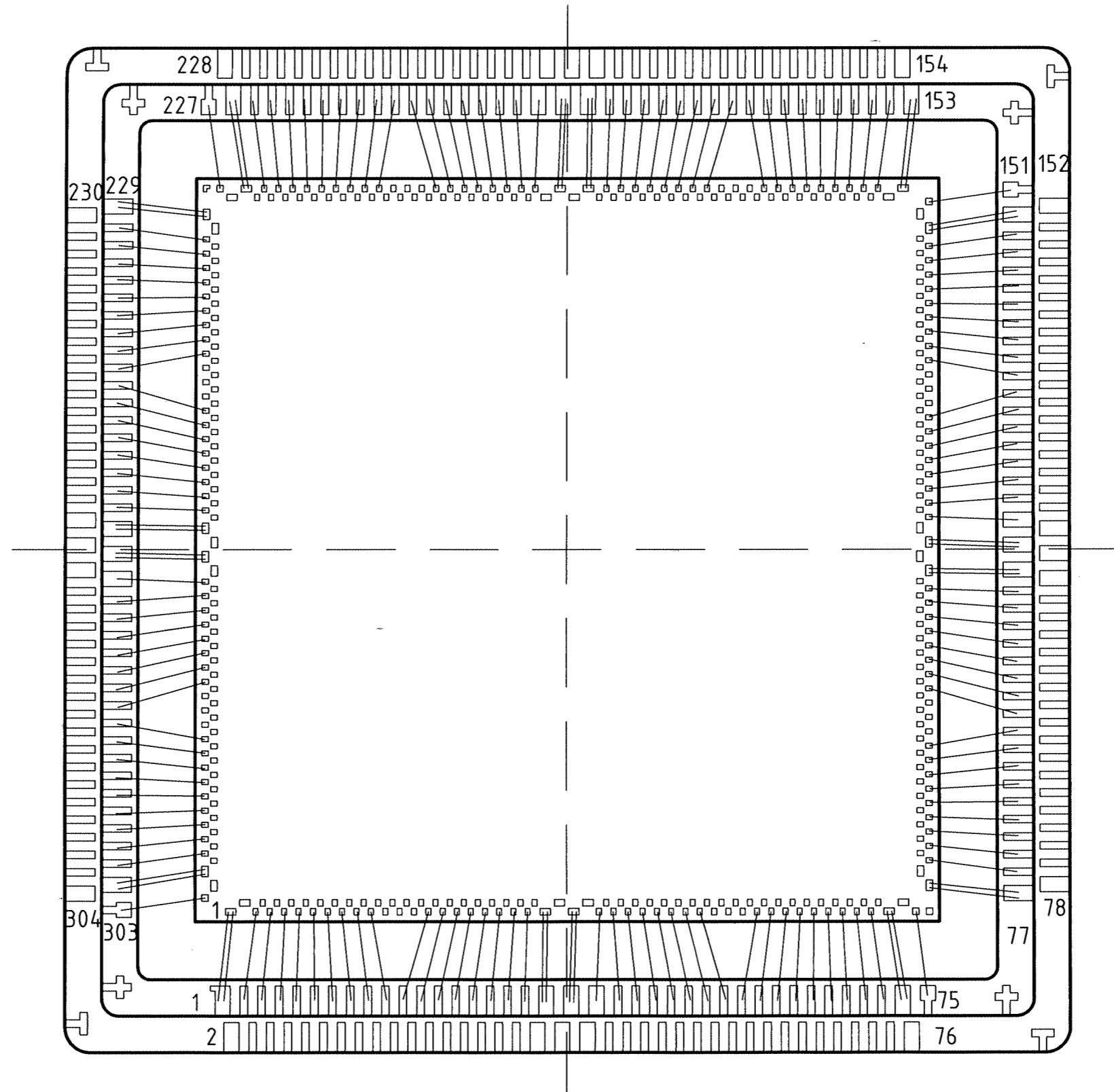
Инв. № подл. 1604	Подп. и дата <i>С.С. Д.И.И.</i>	Взам. инв. № Инв. № дц/дл	Подп. и дата
----------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	<i>С.С. Д.И.И.</i>	<i>С.С. Д.И.И.</i>
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

Рис.2 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.021-01)

Е (10:1) (6)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внутренние площадки колодца



Инв. № подл. 1604	Подп. и дата [Signature]	Взам. инв. № [Signature]	Инв. № дубл. [Signature]	Подп. и дата
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	[Signature]	28.12.19
Изм./Лист	№	Докум.	Подп.	Дата